

Новые IGBT SUNCOYJ в корпусе TO-247 для автотранспорта и промышленности

6 июня



управление питанием | управление двигателем | SUNCOYJ | новость | дискретные полупроводники | IGBT | PTC | TO-247

Китайская компания **SUNCOYJ** выпускает дискретные IGBT-транзисторы [DGW80N120ATL1BQ](#) и [DGW80N120BTL1BQ](#) в популярном корпусе TO-247 с номинальными значениями тока и напряжения 80 А и 1200 В, соответственно. Различие между ними заключается в том, что первый не имеет диода обратного тока, а во втором он есть.

Основное применение DGW80N120ATL1BQ (рисунок 1) – система PTC в электромобилях. Если электротранспорт долго стоит на улице в холодную погоду, то температура его электронного оборудования, а самое главное – аккумулятора может быть ниже рабочей. При старте система PTC сначала включает специальный керамический нагреватель для повышения температуры определенных узлов электромобиля до рабочего значения, и только после этого запускается двигатель, что обеспечивает безопасную и надежную эксплуатацию.

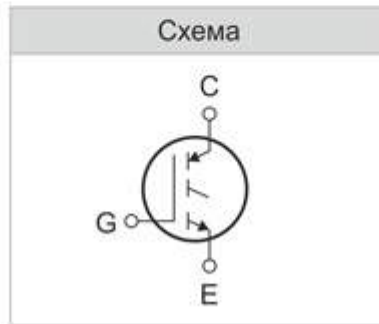
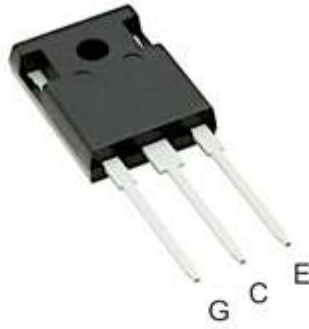
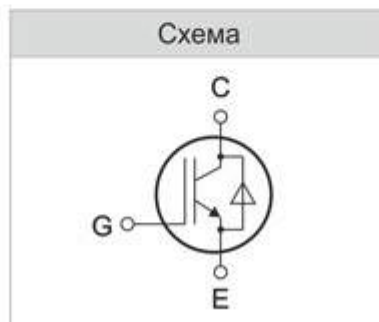


Рис. 1. Схема и расположение выводов DGW80N120ATL1BQ

IGBT-транзисторы DGW80N120BTL1BQ (рисунок 2) рекомендованы для более широкого спектра применений. В частности это могут быть инверторы для питания электромоторов, сервоприводы, что особенно ценно для промышленности, а также они отлично подходят для построения источников бесперебойного питания.



Обе модели удобны для монтажа и отличаются устойчивостью к высоким температурам (выдерживают переход до 150°C). При этом, что важно для силовой электроники, у них положительный температурный коэффициент. Низкое напряжение между коллектором и эмиттером в открытом состоянии, которое составляет всего 1,75 В, обеспечивает малые потери электроэнергии.

Новые IGBT-транзисторы производства компании SUNCOYJ соответствуют стандартам RoHS и AEC-Q101. AEC является международным консорциумом, вырабатывающим стандарты на электронные компоненты, применяющиеся в автомобилях. Требования AEC-Q101 регламентируют испытания компонентов на устойчивость к воздействию статического электричества, механического сдвига контактов и ряда других неблагоприятных факторов. Соответствие транзисторов данному стандарту подтверждает их высокую надежность.